

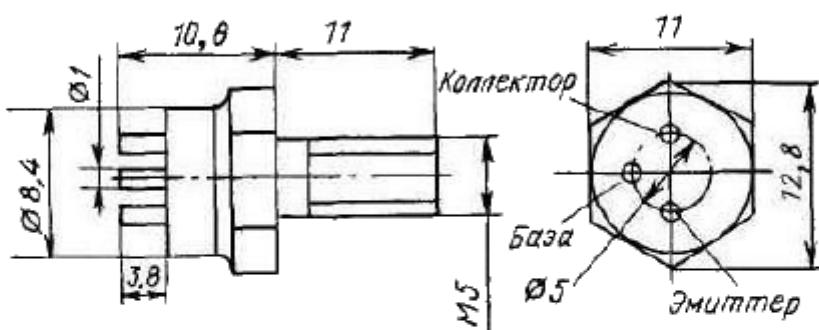
## 2Т921А, КТ921А, КТ921Б

Транзисторы кремниевые плоскоточные  $n-p-n$  и высокочастотные генераторные

Предназначены для работы в тинейных усилителях КВ и УКВ диапазонов при напряжении питания 27 В

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами и монтажным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 6,5 г



## Электрические параметры

Выходная мощность при  $f = 60$  МГц,  $E_K = 27$  В не менее 12,5 Вт  
Коэффициент усиления по мощности при  $P_{\text{вых}} = 12,5$  Вт.

$f = 60$  MHz

2T921A KT921A не меняется

КТ92|Б не менее

Коэффициент подъемного действия коллектора при

$$P_{\max} = [2.5 \text{ Вт}, f = 60 \text{ МГц}] \text{ не менее}$$

2T92|A KT92|A 50%

KT92/E 40 %

Коэффициент комбинационных составляющих третьего

Следовательно, коэффициент усиления звукового тракта порядка при  $f = 30$  МГц,  $P_{\text{вып.пол.}} = 12.5$  Вт не более  $-30$  дБ.

модуль коэффициента передачи тока на  $f = 30$  МГц

при  $U_{\text{бэ}} = 10$  В,  $I_{\text{в}} = 0.4$  А не менее

ПОВОС ЗНАЧИС 7,5\*

WILHELMUS VAN DER HORST, THEATRUM MUNERIS, AMSTERDAM, 1648

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 1$ А не менее . . . . .	10
типовое значение . . . . .	45*
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 1$ А, $f = 10$ МГц не более . . . . .	22 пс
Емкость коллекторного перехода* при $U_{КБ} = 20$ В . . . . .	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода* при $U_{ЭБ} = 3$ В . . . . .	210 пФ
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В не более . . . . .	20 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 70$ В, $R_{ЭБ} =$ = 10 Ом не более . . . . .	10 мА
Индуктивность коллекторного вывода* . . . . .	3,5 нГн
Индуктивность базового вывода* . . . . .	3,5 нГн
Индуктивность эмиттерного вывода* . . . . .	3,0 нГн

### Пределы эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при	
$R_{ЭБ} < 10$ Ом	
при $T_n \leq 398$ К . . . . .	65 В
при $T_n = 423$ К . . . . .	32 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при	
$U_{ЭБ} = 1,5$ В	
при $T_n \leq 398$ К . . . . .	80 В
при $I_n = 423$ К . . . . .	60 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	4 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	3,5 А
Постоянный ток базы . . . . .	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
при $T_k \leq 348$ К . . . . .	12,5 Вт
при $T_k = 398$ К . . . . .	4,2 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме при $E_K \leq 28$ В	
при $T_k \leq 348$ К . . . . .	12,5 Вт
при $T_k = 398$ К . . . . .	4,2 Вт
Температура перехода . . . . .	423 К
Тепловое сопротивление переход-корпус . . . . .	6 К Вт
Температура окружающей среды	
?T921А . . . . .	От 213 до $T_k = 398$ К

Примечание Пайку выводов допускается производить на расстоянии не менее 2 мм от корпуса транзистора. Осевое усилие на винт допускается не более 250 Н, на выводы транзистора не более 5 Н, изгибающее усилие не более 1 Н.